

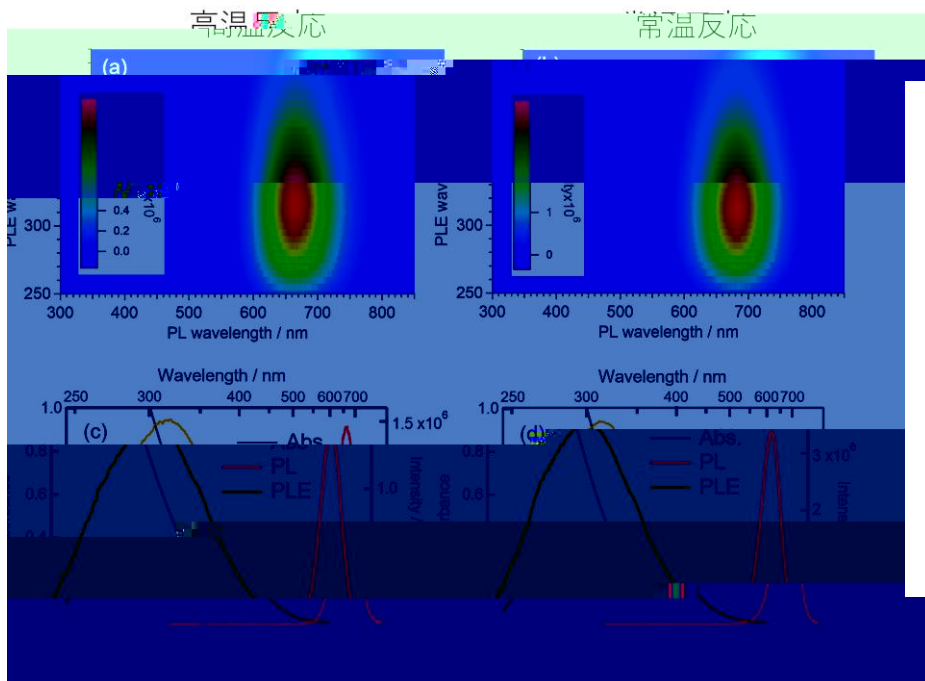
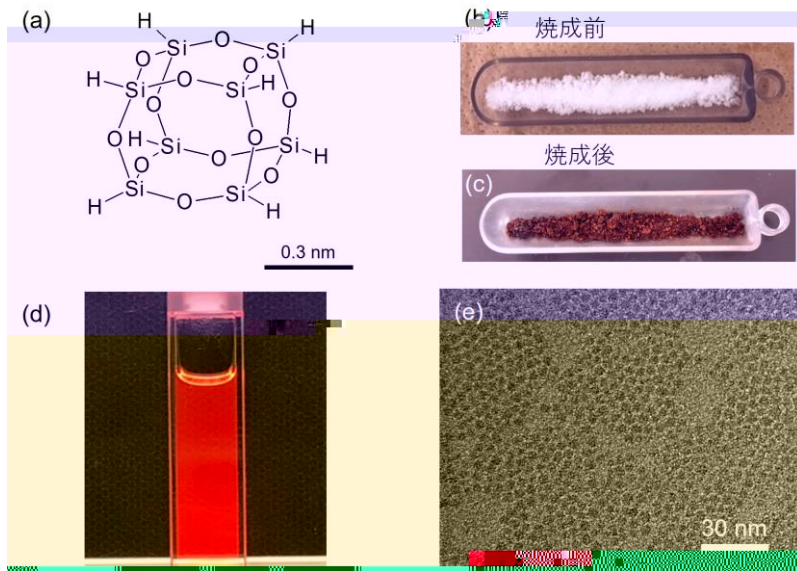
NEWS RELEASE



①

②

-



SiQD	Si-H 基 (%)	Si-H _x 基 (%)	Si-O-Si 基 (%)	Si-C 基 (%)	Si-Cl 基 (%)	ダングリングボンド (%)
高温化学修飾反応	65±5	16±1	≡Si-H ₁	28±6	6.8±1	0.0
		24±2	=Si-H ₂			
		25±1	-Si-H ₃			
		12±1	≡Si-H ₁			
常温化学修飾反応	73±2	32±1	=Si-H ₂	20±1	3.3±0.5	3.5±0.2
		29±1	-Si-H ₃			

